

## ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СВЧ

### Заключение

Таким образом, проведено исследование трех конструкций трансформаторов, выполненных в многослойной GaAs-технологии. Предложен метод программирования конструкции для исследования электромагнитных структур. Получены трансформаторы, обладающие широкой для данного диапазона рабочей полосой частот (1,5—5 ГГц) и имеющие коэффициенты передачи -4...-8 дБ при коэффициентах отражения -15...-20 дБ.

Приведены аналитические зависимости электрических и конструктивных параметров трансформаторов. Представлены результаты моделирования смесителей с использованием полученных трансформаторов, в которых достигнут большой коэффициент передачи при малых значениях шумов, искажений и коэффициенте отражения. При этом исследования проводились в простейших однобалансных схемах. Потери преобразования смесителей составили не более -6...-8 дБ в полосе 1,2—4 ГГц. Динамический диапазон -30...-5 дБ. При использовании двухбалансных схем смесителей следует ожидать лучших результатов.

Трансформаторы могут использоваться в смесителях, усилителях мощности и других монолитных структурах.

### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Kehrer D., Simburger W., Wohlmuth H.-D., Scholtz A. L. Modeling of monolithic lumped planar transformers up to 20 GHz // IEEE Custom Integrated Circuits Conference.— San Diego.— 2001.— Р. 401—404.

2. Шелковников Б. Н., Бондарь Д. Б., Глубоков А. А. Моделирование монолитных планарных трансформаторов на подложке из GaAs / 14-я Междунар. Крымская микроволновая конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии».— Севастополь.— 2004.— С. 16—20.

3. Long J. R. Monolithic transformers for silicon RFIC design // IEEE J. of Solid State Circuits.— 2000.— Vol. 35, N 9.— P. 1368—1392.

4. Long J. R. Monolithic transformers for silicon RFIC design // IEEE J. of Solid State Circuits.— 2000.— Vol. 35, N 9.— P. 1368—1382.

5. Design and Analysis of On-Chip Symmetric Parallel-Plate Coupled-Line Balun for Silicon RF Integrated circuits. H.Y. D. Yang and J. A. Castaneda. Broadcom Corporation, El Segundo, CA 90245.

6. Cheung D. T. S., Long J. R., Hadaway R. A., Harame D. L. Monolithic transformers for silicon RF IC design / Bipolar/BiCMOS Circuits and Technology Meeting.— Minneapolis.— 1998.— P. 105—108.

7. Sevick J. Understanding transformer operation in double-balanced diode mixers // Applied microwave & wireless, 2000, p. 80—81.

8. Ansoft HFSS in versions 5 and 6 and online help / Ansoft Corporation, Pittsburgh, PA 15219.

9. Agilent Advanced design system (ADS), 2002, User Manuals / Agilent technology, Palo Alto, CA 94304.

## ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА НАНО-ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

5-7 декабря 2006 года



**NTMEX - 2006**

Москва, Новый Арбат, 36  
здание Правительства Москвы

#### ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

##### ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗРЕДИЛЕНИЯ: ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ

Производство порошков;  
Производство пленок и нанесение покрытий;  
Производство объемныхnanoструктурных материалов;  
Технологии производства микросхем и их компонентов на основе наноматериалов и нанотехнологий;  
Применение наноматериалов и нанотехнологий в контролируемой и испытательной аппаратуре и т.д.

##### МЕДИИ В АППАРАЧУРНЫЕ КОМПОНОНТЫ: ИЗ ВОЛНОВЫХ АВИАМАТЕРИАЛОВ

Наноробототехника;  
Радио;  
Микрозвук;  
Волоконная оптика;  
Интегральная оптика;  
Лазерная техника;  
Микроструйная техника;  
Микроэлектроника и микроэлектротехника;  
Другие микроэлектронические компоненты;  
Элементы конструкции

##### НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ И МИКРОСХЕМ

Полимерные материалы;  
Функциональные изоляции;  
Наноструктурные газы

##### ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ:

ООО "Компания ММК ПРОФ"  
107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д.21, стр.1  
Телефон: +7(495) 502-19-36, 775-17-20, 502-19-37  
E-mail: [natmex@mail.ru](mailto:natmex@mail.ru) [www.natmex.ru](http://www.natmex.ru)

### SPECIALIZED EXHIBITION OF NANOTECHNOLOGY AND MATERIALS

##### НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ: Физика и химия процессов нанотехнологии; Компоненты нанотехнологии; Классификация по типу (порошки, пленки, покрытия, объемные nanoструктурные материалы); Основные сплошные характеристики наноматериалов и нанотехнологий; Сфера использования наноматериалов и нанотехнологий

##### ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИИ: Консультационные услуги; Передача технологий; Инновационное применение нанотехнологий; Специальная литература в области наноматериалов и нанотехнологий

##### ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДЫША

Здравоохранение;  
Правопорядок и безопасность;  
Строительство и строительная индустрия;  
Топливо-энергетическая химия;  
Охрана окружающей среды;  
Транспорт;

## ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СВЧ

умения найти целесообразный компромисс между требованиями, с одной стороны, высокого уровня радиофизических свойств, а с другой стороны, высокого уровня эксплуатационных показателей, поскольку это — всегда противоречивые требования. Известно, что чем выше концентрация наполнителя при конкретной его дисперсности, тем лучше радиофизические показатели, однако тем хуже показатели механической прочности, выше доля реакционноспособных областей покрытия, ниже устойчивость покрытия к эксплуатации во влажной среде.

3) Многослойные радиоматериалы позволяют реализовать наиболее высокие уровни и радиофизических, и эксплуатационных показателей, однако требуют больших затрат времени на изготовление, поскольку нанесение последующего слоя осуществляется лишь после отверждения предыдущего. Этот недостаток целесообразно преодолевать применяя высокочастотный нагрев отверждаемой смеси наполнителя и связующего. При этом процесс отверждения ускоряется в сотни раз, а доля реакционноспособ-

ных областей композита уменьшается примерно в четыре раза [8].

### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Демьянчук Б. А. Принципы и применения микроволнового нагрева.— Одесса: Черноморье, 2004.
2. Кингстон Г. М., Джесси Л. Б. Пробоподготовка в микроволновых печах.— М.: Мир, 1991.
3. ГОСТ 12.1.006–76. Предельно допустимые нормы плотности потока энергии электромагнитных полей.
4. ОСТ 4ГО. 054.102. Поглотители высокочастотной энергии.
5. Хиппель А. Р. Диэлектрики и волны.— М.: Изд-во иностр. литер., 1960.
6. Демьянчук Б. А. Коэффициент преобразования электромагнитной энергии в тепловую в кусочно-однородной среде с градиентом потерь // Сб. науч. трудов ОИСВ.— 2003.— № 8.— С. 36–40.
7. Демьянчук Б. А. Многокритериальное сопоставление экранирующих композитных преобразователей электромагнитной энергии в тепловую // Там же.— 2004.— № 9.— С. 31–38.
8. Штурман А. А., Черкашин А. Н. Ускоренное отверждение эпоксидных композитов в поле ТВЧ // Пластичные массы.— 1987.— № 6.— С. 38–41.

## ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ

